特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

REC'D 2 0 MAY 2005
WIPO PCT

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]

出願人又は代理人 の書類記号 PH-2063-PCT	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP2004/004512	国際出願日 (日. 月. 年) 30.03.2004	優先日 (日.月.年) 31.03.2003					
国際特許分類(I P C)Int.Cl. ⁷ H01L27/105, H01L43/08							
出願人 (氏名又は名称) 独立行政法人科学技術振興機構							

1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。								
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で4 ページからなる。								
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. 「 附属書類は全部で ページである。								
「 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則 70.16及び実施細則第607号参照)								
「 第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙								
(電子媒体の種類、数を示す)。								
b. 電子媒体は全部で								
配列表に関する補充機に示すように、コンピューグ記み取り引記なわれたように入れている。(実施細則第802号参照)								
フルと自己。 (文 加州内内の 002 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00								
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。								
▽ 第1機 国際予備審査報告の基礎								
 「 第Ⅱ欄 優先権 「 第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成								
▽ 第IV柵 発明の単一性の欠如 ▽ 第V柵 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付								
けるための文献及び説明								
ア 第VI欄 ある種の引用文献								
「第VII欄 国際出願の不備								
「 第 ¹ 四欄 国際出願に対する意見								

国際予備審査の請求咨を受理した日 01.10.2004	国際予備審査報告を作成した日 28.04.2005
名称及びあて先 日本国特許庁(I PEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区段が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 正山 旭 電話番号 03-3581-1101 内線 3462

第I欄	報告の基礎							
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。								
 	この報告は、							
2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)								
V	出願時の国際出願書類							
Γ	明細書 第 ページ、出願時に提出されたもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの							
r	請求の範囲 項、出願時に提出されたもの 第							
r	第 ページ/図、出願時に提出されたもの 第 ページ/図* 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ/図* 付けで国際予備審査機関が受理したもの							
з. Г	補正により、下記の書類が削除された。							
4. F	この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))							
* 4	. に該当する場合、その用紙に "superseded" と配入されることがある。							

第IV欄 発明の単一性の欠如

- 1. 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求めに対して、出願人は、
 - | 請求の範囲を減縮した。
 - □ 追加手数料を納付した。
 - 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。
 - □ 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。
- 2. 🔽 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。
- 3. 国際予備審査機関は、PCT規則 13.1、13.2 及び 13.3 に規定する発明の単一性を次のように判断する。
 - 満足する。
 - ▽ 以下の理由により満足しない。

文献1:LeClair, P. et al. "Large magnetoresistance using hybrid spin filter devices" Appl. Phys. Lett. 28 January 2002, Vol. 80, No. 4, pages 625-627

文献 2: MATSUKURA, F. et al. "Control of ferromagnetism in field-effect transistor of a magnetic semiconductor", Physica E, Vol. 12, Issues, January 2002, pages 351-355

請求の範囲に記載されている一群の発明が単一性の要件を満たすには、その一群の発明を単一の一般的発明概念を形成するように連関させるための、特別な技術的特徴の存在が必要であるところ、請求の範囲1-99に記載されている一群の発明は、ソースとドレインとの間に設けられた「強磁性体」という事項でのみ連関していると認めるが、この事項は、文献1 (特に、Fig.1, Fig.2及び図面説明箇所)、及び、文献2 (特に、Fig.1及び図面説明箇所)に記載されているため、特別な技術的特徴とはなり得ない。

そうすると、請求の範囲1-99に記載されている一群の発明の間には、単一の一般的発明概念を形成するように連関させるための、特別な技術的特徴は存在しないこととなる。そのため、請求の範囲1-99に記載されている一群の発明が発明の単一性の要件を満たしていないことは明らかである。

4. したがって、国際出願の次の部分について、この報告を作成した。

▼ すべての部分

間求の範囲

に関する部分

		特許性に関する国際予備報告	Ť	İ	国際出願否号	PC1/JP20
第V概		、進歩性又は産業上の利用可能 取付ける文献及び説明	を性についての	去第 12 条	(РСТ35条(2	()) に定める見解、
1.	見解					

新規性(N)

請求の範囲 1-33,36-99____ 訪求の範囲 34,35

有 請求の範囲 ____ 進歩性(IS)

請求の範囲 _____1-99_____

有 請求の範囲 1-99 産業上の利用可能性(IA) 請求の範囲

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献1:LeClair, P. et al. "Large magnetoresistance using hybrid spin filter devices" Appl. Phys. Lett. 28 January 2002, Vol. 80, No. 4, pages 625-627 文献 2:MATSUKURA, F. et al. "Control of ferromagnetism in field-effect transistor of a magnetic semiconductor", Physica E, Vol. 12, Issues, January 2002, pages

文献 3: JP 11-238924 A(株式会社東芝)1999.08.31 文献 4 : IP 2001-250998 A(東北大学長)2001.09.14

文献 5: 菅原聡 他, スピンフィルタ・トランジスタの提案とその応用, 第50回応用物 理学関係連合講演会講演予稿集, 2003. 03. 27, No. 3, p. 1566, 30a-ZH-1

請求の範囲1-11、12に係る発明については、文献1、3、4、5から進歩性 を有しない。文献1及び文献5のキャリアのエネルギーバンド端がスピン分裂した強 磁性トンネル障壁を、文献3、文献4のトランジスタのトンネル障壁に適用すること は容易である。

請求の範囲13-14、15-16に係る発明については、文献1、3、4、5か ら進歩性を有しない。トンネル障壁との接合構造体の接合面を、基板に対し、どのよ

うに向けるかは、当業者にとって設計的事項の範疇である。 請求の範囲17-33に係る発明については、文献1、3、4、5から進歩性を有 しない。スピントランジスタを記憶素子及び記憶回路に適用することは文献3、4に 記載されており、また、記憶素子及び記憶回路に伴う配線構造等は、当業者にとって 設計的事項の範疇である。

請求の範囲34に係る発明については、文献1から新規性・進歩性を有さない。文 献1のFig.1の強磁性トンネル障壁を有した構造は、本請求項の「2端子磁気抵抗素 子」に対応する。

請求の範囲35に係る発明については、文献2のFig.1及び図面説明箇所から新規

性・進歩性を有さない。 請求の範囲36-38、39、40、41-43、44、45-71に係る発明については、文献1、2、3、4、5から進歩性を有しない。強磁性体トンネル障壁については、文献1及び文献5を、トンネル障壁を用いたトランジスタについては、文献3及び文献4を参照されたい。また、トンネル障壁との接合構造体の接合面を、基板に対し、どのように向けるかは、当業者にとって設計的事項の範疇である。

請求の範囲 72-99に係る発明については、文献 1、2、3、4、5から進歩性を有しない。スピントランジスタを記憶素子及び記憶回路に適用することは文献 3、 4に記載されており、記憶素子及び記憶回路に伴う配線構造等は、当業者にとって設 計的事項の範疇である。